

## 1 適用範囲

## Scope

この規格は、FMXK-2206Sについて適用する。

The present specifications shall apply to FMXK-2206S.

## 2 概要

## Outline

## High Frequency Rectification

|                   |        |  |
|-------------------|--------|--|
| 種<br>Type         | 別      | 拡散型ダイオード<br>Silicon Diode                    |
| 構<br>Structure    | 造      | 樹脂封止型<br>Resin Molded                        |
| 主<br>Applications | 用<br>途 | 高周波整流用等<br>High Frequency Rectification, etc |

## 3 不燃化度

## Flammability

規格 UL94V-0 相当品

UL94V-0(Equivalent)

Not Recommended for New Designs

## 4 絶対最大定格

Absolute maximum ratings

| No. | 項目<br>Item                                   | 記号<br>Symbol | 単位<br>Unit | 定格<br>Rating | 条件<br>Conditions                          |
|-----|--|--------------|------------|--------------|---|
| 1   | ピーク非繰返し逆電圧<br>Transient Peak Reverse Voltage | $V_{RSM}$    | V          | 600          |   |
| 2   | ピーク繰返し逆電圧<br>Peak Reverse Voltage            | $V_{RM}$     | V          | 600          |   |
| 3   | 平均順電流<br>Average Forward Current             | $I_{F(AV)}$  | A          | 20           | 7項減定格参照<br>Refer to Derating curve of 7   |
| 4   | サージ順電流<br>Peak Surge Forward Current         | $I_{FSM}$    | A          | 100          | 10msec. 正弦半波単発<br>Half sinewave, one shot |
| 5   | $I^2t$ 限界値<br>$I^2t$ Limiting Value          | $I^2t$       | $A^2s$     | 50           | 1msec $t$ 10msec                          |
| 6   | 接合部温度<br>Junction Temperature                | $T_j$        |            | -40~+150     |   |
| 7   | 保存温度<br>Storage Temperature                  | $T_{stg}$    |            | -40~+150     |   |

No.1,2,4,5 は一素子当たりの定格を示す。

No.1,2,4&amp;5 show ratings per one chip.

## 5 電気的特性

Electrical characteristics

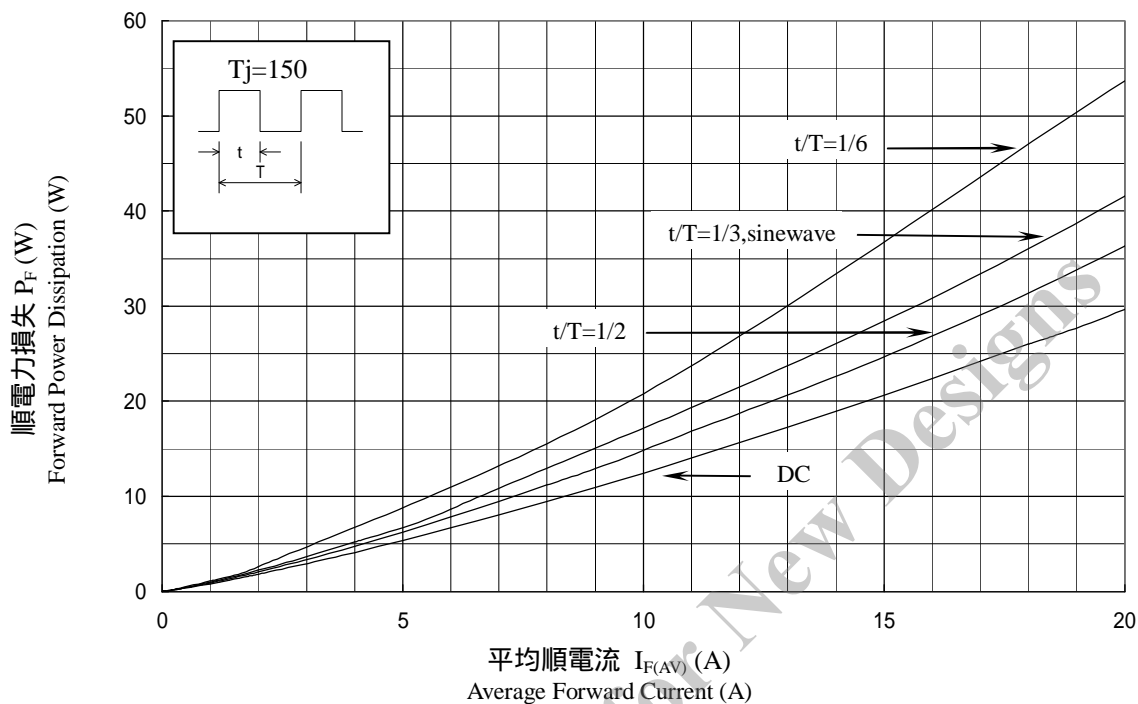
| No. | 項目<br>Item   | 記号<br>Symbol  | 単位<br>Unit | 特性<br>Value | 条件<br>Conditions                                   |
|-----|--|---------------|------------|-------------|--|
| 1   | 順方向降下電圧<br>Forward Voltage Drop                                | $V_F$         | V          | 1.75 max.   | $I_F=10A$  |
| 2   | 逆方向漏れ電流<br>Reverse Leakage Current                             | $I_R$         | $\mu A$    | 100 max.    | $V_R=V_{RM}$                                       |
| 3   | 高温逆方向漏れ電流<br>Reverse Leakage Current Under<br>High Temperature | $H \cdot I_R$ | mA         | 10 max.     | $V_R=V_{RM}, T_j=150$                              |
| 4   | 逆方向回復時間<br>Reverse Recovery Time                               | trr           | ns         | 27 max      | $I_F=I_{RP}=500mA$<br>75% Recovery point, $T_j=25$ |
| 5   | 熱抵抗<br>Thermal Resistance                                      | $R_{th(j-c)}$ | /W         | 4 max.      | 接合部 - 裏面取付け穴周辺部<br>Between Junction and case       |

No.1,2,3,4 は一素子当たりの特性を示す。

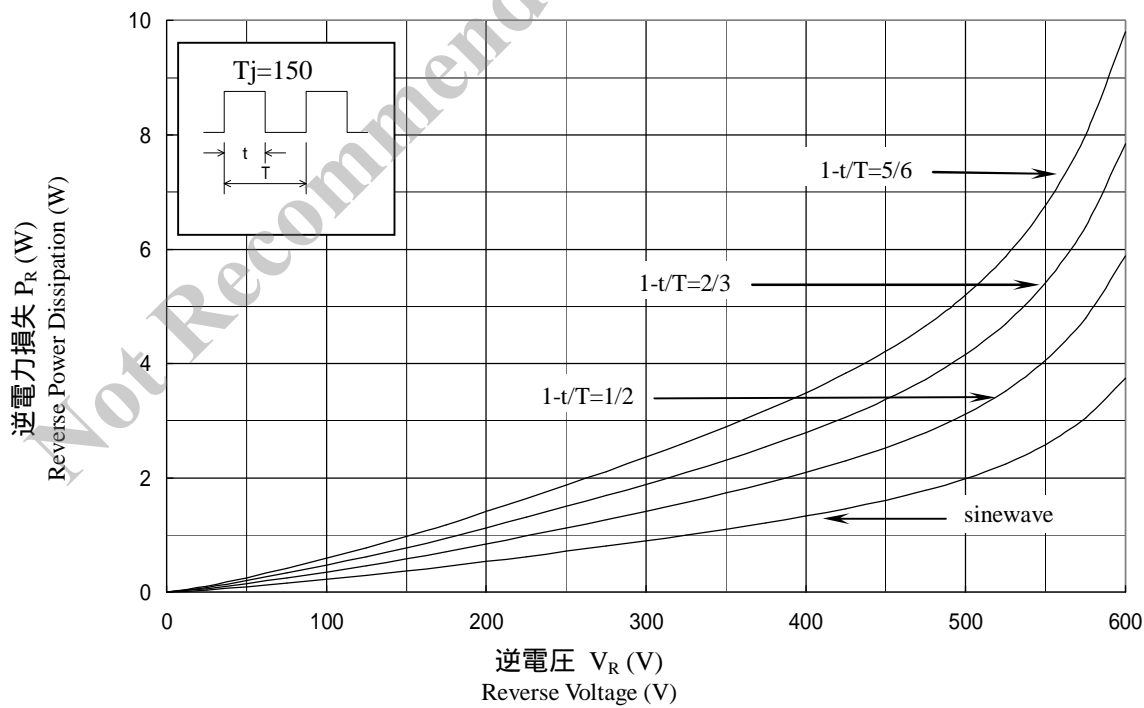
No.1,2,3&amp;4 show characteristics per one chip.

6 特性  
Characteristics

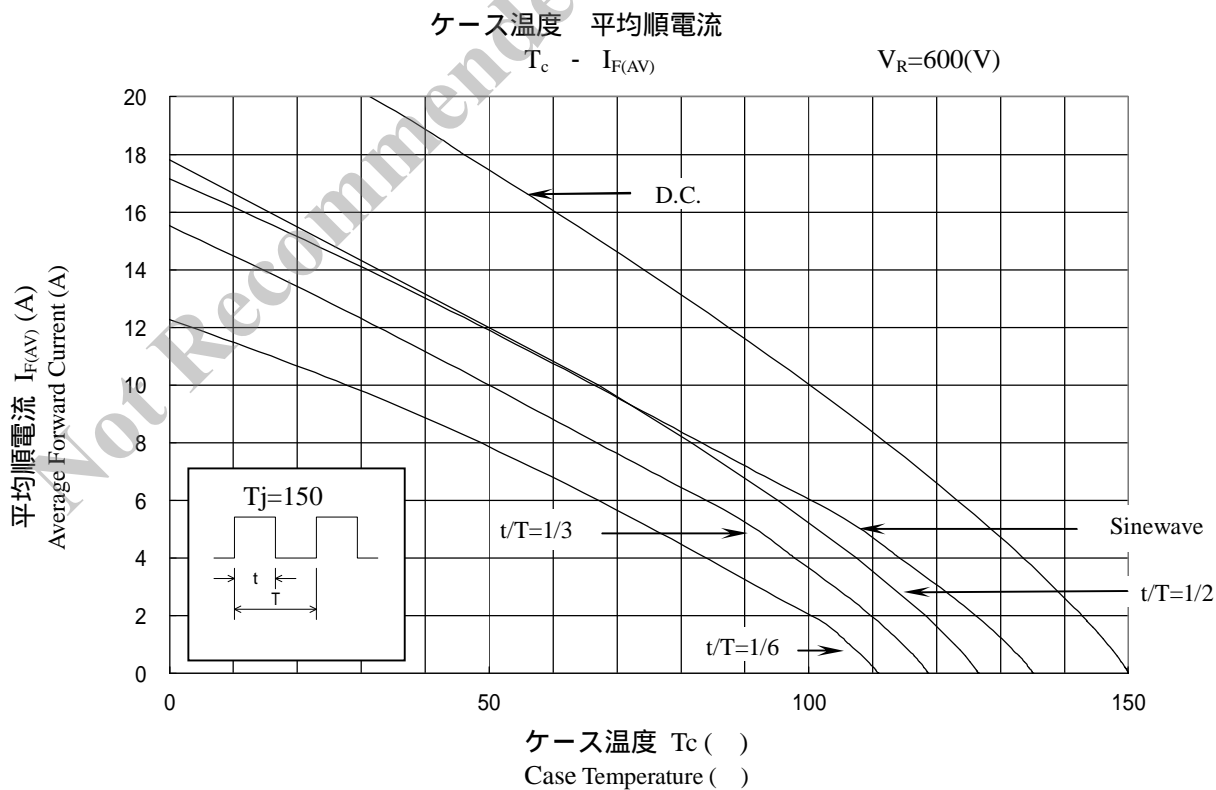
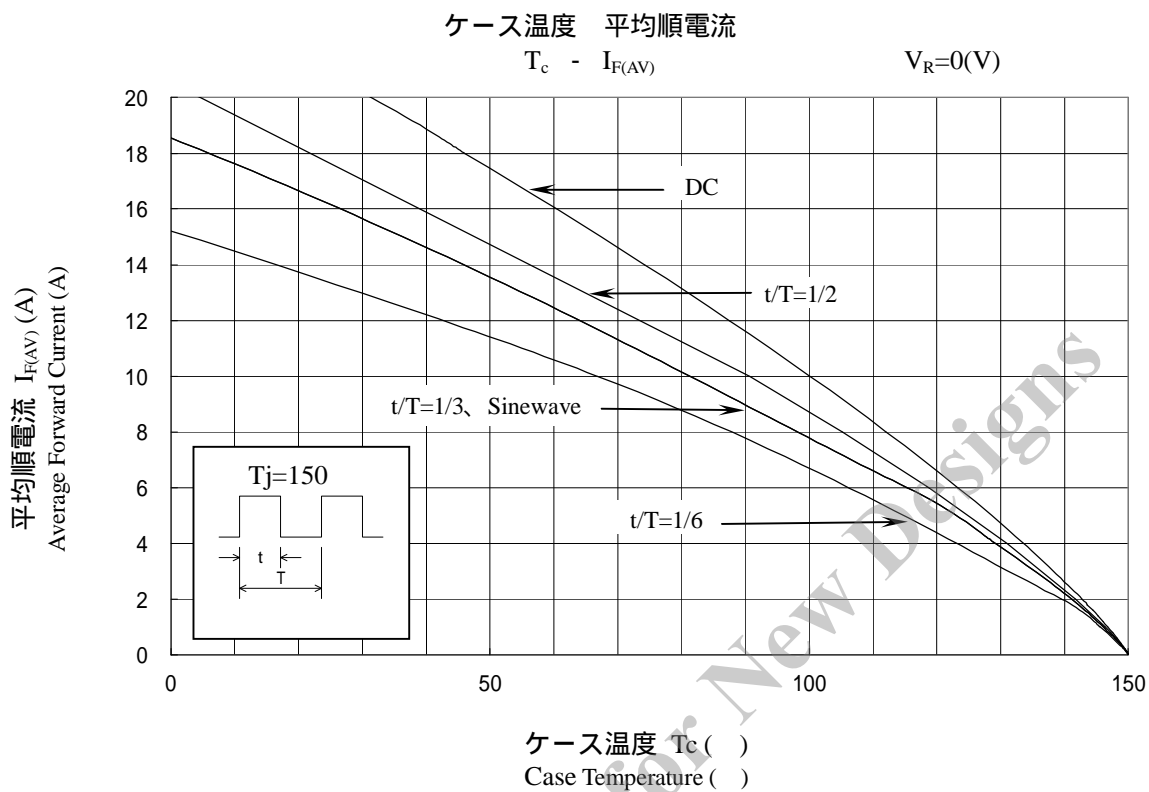
平均順電流 順電力損失  
 $I_{F(AV)} - P_F$



逆電圧 逆電力損失  
 $V_R - P_R$



7 減定格  
Derating

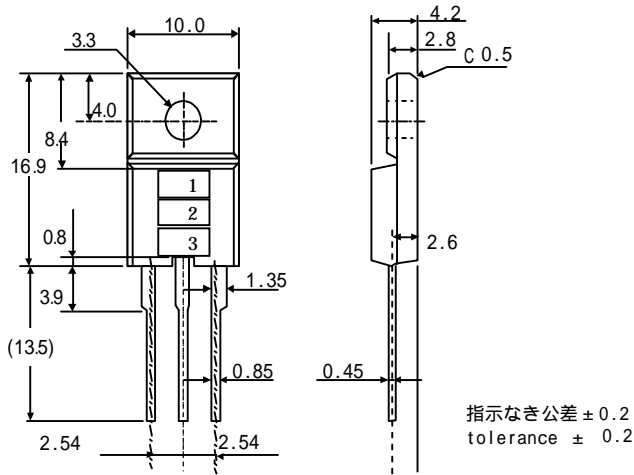


8 外形

Package information

8-1 外形、寸法および材質

Package type, physical dimensions and material



単位 : mm  
Dimensions in mm

8-2 外観

Appearance

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。

The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw.

8-3 標示

Marking

| 品名<br>Type Name | 標 示<br>Marking    |                  |  |
|-----------------|-------------------|------------------|--|
|                 | 1 品名<br>Type Name | 2 極性<br>Polarity | 3 ロット番号<br>Lot number  |
| FMXK-2206S      | XK2206            |                  | 第 1 文字 : 年(西暦年号下一桁)<br>1st letter: Last digit of year<br>第 2 文字 : 月 1~9月 1~9<br>2nd letter: Month From 1 to 9 for Jan. to Sep.,<br>10月 O、11月 N、12月 D<br>O for Oct., N for Nov., D for Dec.<br>第 3,4 文字 : 日<br>3rd & 4th letter: Day<br>例 : 8618 (2008年 6月 18日製造)<br>ex. 8618 (Jun. 18, 2008) |